

日韓共同応用物理シンポジウム「量子材料・デバイスと先端半導体」

日時：2025年9月8日(月)13:00～18:00
会場：名城大学 天白キャンパス&オンライン

日本と韓国の応用物理分野の交流を図るため、応用物理学会と韓国物理学会(KPS)の共同シンポジウムを企画しました。今回は「量子材料・デバイスと先端半導体」をテーマとし、両国のこの分野の研究・開発動向について議論します。2次元材料、量子技術、ワイドギャップ半導体電子デバイスなど、幅広く扱います。

招待講演

From JSAP

“Fabrication of Transfer-Free Graphene FETs Utilizing the Catalyst Metal Agglomeration Technique with Fine Ni Patterns”

Toshiharu Kubo (Nagoya Inst. Tech.)

“Water-Induced Instability and Its Enhancement in Field-Effect Transistors Based on 2D Layered Materials”

Ryo Nouchi (Osaka Metropolitan Univ.)

“N-Polar GaN-Based Heterostructures: Challenges and Opportunities”

Tetsuya Suemitsu (Tohoku Univ.)

“GaN-on-Diamond HEMTs with Suppressed Self-Heating Effects”

Naoteru Shigekawa (Osaka Metropolitan Univ.)

From KPS

“Site- and Density-Controlled Single Photon Emitters with Quantum Dots, Defects, and Nanoparticles Coupled with Photonic Structures”

Yong-Hoon Cho (KAIST)

“2D Materials beyond the Limit of 3D Bulk Semiconductors”

Hyesung Park (Korea Univ.)

“Contact Engineering in Atomically Thin 2D Electronics”

Sangyeon Pak (Hongik Univ.)

“Physical Reservoir Computing Using Artificial Synaptic Devices”

Hongseok Oh (Soongsil Univ.)

“Growth of Semiconductor Type-II Quantum Nanostructures by Droplet Epitaxy”

Jong Su Kim (Yeungnam Univ.)